

Начальнику управления
подготовки и аттестации кадров
высшей квалификации
РГПУ им. А.И. Герцена
Лактионову А.А.

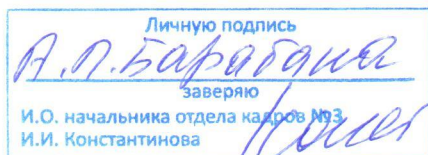
Уважаемый Андрей Александрович

Я, Барабан Александр Петрович, даю согласие выступить в качестве оппонента по диссертации Смирнова Александра Павловича на тему «Сенсibilизированные фотопроцессы в системе стеарат серебра – галогенид серебра», представленной на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.3.8. Физика конденсированного состояния. Даю свое согласие на обработку моих персональных данных.

Доктор физико-математических наук,
профессор, заведующий кафедрой электроники
твёрдого тела Санкт-Петербургского
государственного университета



А. П. Барабан



Сведения об официальном оппоненте

по диссертации Смирнова Александра Павловича на тему: «Сенсибилизированные фотопроцессы в системе стеарат серебра – галогенид серебра» на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.3.8 Физика конденсированного состояния, представленной к рассмотрению в диссертационном совете 99.2.018.02 на базе Российского Государственного Педагогического Университета им. А. И. Герцена, Национального исследовательского университета ИТМО.

Фамилия Имя Отчество	Барабан Александр Петрович
Ученая степень (шифр специальности по диплому), ученое звание	Доктор физико-математических наук (01.04.10, Физика полупроводников и диэлектриков). профессор
Место работы, должность	Санкт-Петербургский Государственный Университет, кафедра электроники твердого тела, заведующий кафедрой
Почтовый индекс, адрес	198504г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, Петергоф, ул. Ульяновская, д. 1, корп. М
Контактный телефон	428-44-98, 428-44-49
Адрес электронной почты	a.baraban@spbu.ru

Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации за последние 5 лет (не более 15 публикаций)	
1.	Мышкин В.Ф., Ван Ц., Хан В.А., Барабан А.П., Побережников А.Д., Шукшина Д.Д. Распространение ионов и молекул воды по поверхности частицы иллита //Известия высших учебных заведений. Физика, 2022. Т. 65, № 4 (773). С. 20-24.
2.	Wang C., Myshkin V.F., Khan V.A., Poberezhnikov A.D., Baraban A.P. Effect of temperature on the diffusion and sorption of cations in clay vermiculite //ACS Omega. 2022. Т. 7. № 14. С. 11596-11605.
3.	Барабан А.П., Дмитриев В.А., Габис И.Е., Петров Ю.В., Прокофьев В.А. Совместный анализ спектров катодолуминесценции и электролюминесценции слоев Si-SiO ₂ на кремнии // Оптика и спектроскопия. 2021. Т. 129. № 12. С. 1526-1530.
4.	Baraban A.P., Dobrotvorskii M.A., Elets D.I., Gabis I.E., Kuznetsov V.G., Voyt A.P., Selivanov A.A., Piven V.A. Synthesis and properties of hydrogenated aluminum thin film by reactive sputtering // Thin Solid Films. 2020. Т. 709. С. 138217.
5.	Baraban A.P., Dmitriev V.A. Luminescence of insulator layers on silicon excited by electrons // Physics of Complex Systems. 2021. Т. 2. № 1. С. 9-14.
6.	Baraban A.P., Denisov E.A., Dmitriev V.A., Drozd A.V., Drozd V.E., Selivanov A.A., Seisyan R.P. Features of SiO ₂ layers synthesized on silicon by molecular layer deposition // Semiconductors. 2020. Т. 54. № 4. С. 506-510.
7.	Petrov Y.V., Grigoryev E.A., Baraban A.P. Helium focused ion beam irradiation with subsequent chemical etching for the fabrication of nanostructures // Nanotechnology. 2020. Т. 31. № 21. С. 215301.
8.	Барабан А.П., Дмитриев В.А., Дрозд В.Е., Петров Ю.В., Прокофьев В.А. Электролюминесценция слоев Ta ₂ O ₅ , полученных методом молекулярного напыления // Оптика и спектроскопия. 2020. Т. 128. № 2. С. 224-227.
9.	Барабан А.П., Денисов Е.А., Дмитриев В.А., Дрозд А.В., Дрозд В.Е., Селиванов А.А.,

	Сейсян Р.П. Особенности слоев SiO ₂ , синтезированных на кремнии методом молекулярного наслаивания // Физика и техника полупроводников. 2020. Т. 54. № 4. С. 427-431.
10.	Барабан А.П., Селиванов А.А., Дмитриев В.А., Дрозд А.В., Дрозд В.Е. Катодоллюминесценция слоев TiO ₂ , полученных методом молекулярного наслаивания // Письма в Журнал технической физики. 2019. Т. 45. № 6. С. 13-15.
11.	Baraban A.P., Samarin S.N., Prokofiev V.A., Dmitriev V.A., Selivanov A.A., Petrov Y.V. Luminescence of SiO ₂ layers on silicon at various types of excitation // Journal of Luminescence. 2019. Т. 205. С. 102-108.
12.	Gritsenko V.A., Gismatulin A.A., Baraban A.P., Chin A. Mechanism of stress induced leakage current in Si ₃ N ₄ // Materials Research Express. 2019. Т. 6. № 7. С. 076401.
13.	
14.	
15.	

Подпись официального оппонента



Барабан А.П.

